








	<h2>SI7784DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7784DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7784DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7784DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 5W (Ta), 27.7W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 27.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7784DP-T1-GE3DKR

SI7784DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7784DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7784DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7784DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI7788DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8	 SI7772DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8	 SI7788DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	 SI7772DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8
 SI7784DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8	 SI7774DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	 SI7774DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	 SI7790DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8

heiße Teile

Mehr

 SI7720DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-GE3	 SI7726DN	 SI7726DN-T1-E3	 SI7726DN-T1-GE3
 SI7726DN-T1-GE3	 SI7732DP-T1-GE3	 SI7738DP	 SI7738DP-T1-3	 SI7738DP-T1-E3
 SI7738DP-T1-E3	 SI7738DP-T1-GE3	 SI7738DP-T1-GE3	 SI7742DP-T1-E3	 SI7742DP-T1-GE3
 SI7742DP-T1-GE3	 SI7748DP-T1-GE3	 SI7748DP-T1-GE3	 SI7758DP	 SI7758DP-T1-GE3
 SI7758DP-T1-GE3	 SI7772DP-T1-GE3	 SI7772DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3
 SI7784DP-T1-GE3	 SI7788DP-T1-GE3	 SI7788DP-T1-GE3	 SI7790DP-T1-E3	 SI7790DP-T1-GE3
 SI7790DP-T1-GE3	 SI7792DP-T1-GE3	 SI7792DP-T1-GE3	 SI7794DP-T1-GE3	 SI7794DP-T1-GE3
 SI7798DP-T1-GE3	 SI7804DN	 SI7804DN-T1-E3	 SI7804DN-T1-E3	 SI7806ADN
 SI7806ADN-T1-E3	 SI7806ADN-T1-E3	 SI7806ADN-T1-E3-PBF	 SI7806ADN-T1-GE3	 SI7806ADN-T1-GE3
 SI7806AEDN-T1-E3	 SI7806BDN	 SI7806BDN-T1-GE3	 SI7806DN-T1-E3	 SI7806DN-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited